



УСТАНОВКА ГАЗОФАЗНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ С ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОДЛОЖЕК

ЭПИ ЕТМ

Назначение:

Осаждение эпитаксиальных слоев кремния в широком диапазоне толщин и удельных сопротивлений на монокристаллические подложки кремния или сапфира хлоридным или хлоридно-гидридным методом осаждения из газовой фазы.

Особенности:

- Кварцевый реактор цилиндрического типа с индукционно-радиационным нагревом подложек;
- Высокочастотный испаритель кремнийсодержащего вещества ;
- Неограниченный срок службы кварцевого реактора;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 100 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 10 м².

